

電気学会研究会資料目次

電子材料研究会

テーマ「超高速 SiGe デバイス材料技術の最新動向」

〔委員長〕奥村 次徳（都立大）

〔幹事〕岡田 至崇（筑波大），羽路 伸夫（横国大）

日時 平成16年6月26日（土） 10:00～17:00

場所 東京農工大学 工学部 新1号館 1F 0111番大講義室

（小金井市中町2-24-16、中央線東小金井駅南口から徒歩8分、武蔵小金井駅南口から徒歩13分）

EFM-04-26 SiGe プロセスにおけるガス精製 / 除害技術

富田修康，小野宏之，羽坂 智（日本酸素）..... 1

EFM-04-27 超高速 SiGe デバイス量産に向けた縦型 SiGe エピタキシャル成長装置

国井泰夫，黒河治重（日立国際電気）

室田淳一（東北大学）..... 5

EFM-04-28 枚葉式エピ装置と Si/SiGe 系薄膜成長への適用

武藤勝彦（日本エー・エス・エム）..... 9

EFM-04-29 歪緩和 SiGe バッファ層の欠陥制御と高品質化

酒井 朗，財満鎮明（名古屋大学）

安田幸夫（高知工科大学）..... 15

EFM-04-30 基板非加熱 ECR プラズマ照射による Si-Ge 系薄膜の CVD エピタキシャル成長

櫻庭政夫，武藤大祐，森 聖樹，菅原勝俊，室田淳一（東北大学）..... 21

EFM-04-31 非晶質基板上における SiGe 薄膜の低温成長

宮尾正信，角田 功，菅野裕士，佐道泰造，権丈 淳（九州大学）..... 27

EFM -04-32	Ge ドットデバイスと SiGe 共鳴トンネルデバイス 須田良幸，北山大祐，前川裕隆（東京農工大学）.....	33
EFM -04-33	SiGe/Si/Si-pin ダイオードの高速リカバリメカニズム 廣瀬文彦，高橋 豊，向田昌志（山形大学）.....	39
EFM -04-34	歪み制御によるショットキーバリアエンジニアリングを用いたサブ 100nm ショットキーソース/ドレイン MOSFET 池田圭司，山下良美，遠藤 聡，彦坂康己，三村高志（富士通研究所）.....	43
EFM -04-35	SiGe/Si ヘテロ MOSFET におけるヘテロ界面準位密度の直接測定と低周波 雑音特性 土屋敏章（島根大学） 室田淳一（東北大学）.....	49
EFM -04-36	サブ 0.1 μ m SOI-MOSFET のための SiGe Elevated Source/Drain と Ni Silicide 栗野浩之，坂口武史，呉 赫宰，沈 正七，小柳光正（東北大学）.....	55
EFM -04-37	高性能サブ 100nm CMOS 用の新しい多結晶ゲート制御技術 上嶋和也，山本豊二，最上 徹（日本電気）.....	59
EFM -04-38	ひずみ SOI CMOS 技術 高木信一（MIRAI-AIST，東京大学） 水野智久，手塚 勉，杉山直治， 沼田敏典，臼田宏治，中払 周（MIRAI-AIST） 守山佳彦，古賀淳二，田邊顕人， 平下紀夫，入沢寿史，前田辰郎（MIRAI-AIST）.....	63
EFM -04-39	SiGe デバイスの無線端末への適用 末松憲治，谷口英司，新庄真太郎（三菱電機）.....	69
EFM -04-40	SiGe HBT/BiCMOS の高速・高周波通信用 IC への応用 増田 徹，白水信弘，中村宝弘，花沢 聡（日立製作所） 田邊正倫（ルネサス北日本セミコンダクタ） 三浦 真，富成達也（日立製作所） 島本裕己（ルネサス北日本セミコンダクタ） 橋本 尚，原田 卓，長嶋敏夫，鷲尾勝由（日立製作所）.....	73

共 催 応用物理学会 シリコンテクノロジー分科会研究集会